

#### PNP SILICO

# H1020

PNP SILICON TRANSISTOR

对应国外型号 2SA1020

## 主要用途

#### 功率放大、开关应用。

#### 极限值(T<sub>a</sub>=25)

T <sub>stg</sub> ——贮存温度	-55~150
T <sub>j</sub> ——结温	150
P <sub>C</sub> ——集电极耗散功率	900mW
V <sub>CBO</sub> ——集电极—基极电压	50V
V <sub>CEO</sub> ——集电极—发射极电压	50V
V <sub>EBO</sub> ——发射极—基极电压	5V
Ic——集电极电流	2 <i>A</i>

## 外形图及引脚排列

TO-92



- 1 发射极,E
- 2 集电极,C
- 3 基 极,B

## 电参数(T<sub>a</sub>=25)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单 位	测试条件
ВУсво	集电极—基极击穿电压	-50			V	IC=-1mA , IE=0
BVceo	集电极—发射极击穿电压	-50			V	IC=-10mA , $IB=0$
BV <sub>EB0</sub>	发射极—基极击穿电压	-5			V	IE=-1mA , $IC=0$
I сво	集电极—基极截止电流			-1.0	μΑ	Vcb=-50V, I E=0
I EBO	发射极—基极截止电流			-1.0	μΑ	VEB=-5V, I C=0
HFE (1)	直流电流增益	70		240		Vce=-2V, $Ic=-0.5A$
HFE (2)		40				Vce=-2V, Ic=-1.5A
VCE(sat)	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	Ic=-1A, IB=-0.05A
VBE(sat)	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	Ic=-1A , IB=-0.05A
fī	特征频率		100		MHz	Vce=-2V, $Ic=-0.5A$
Cob	共基极输出电容		40		рF	Vcb=-10V, I E=0
						f=1MHz
ton	导通时间		0.1		μS	
tsтg	贮存时间		1.0		μS	按特定测试电路
tr	下降时间		0.1		μS	J

## 分档及其标志

0 Y 70—140 120—240